










	<p><b>SPD02N80C3ATMA1</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SPD02N80C3ATMA1</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 800V 2A 3TO252</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SPD02N80C3ATMA1.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SPD02N80C3ATMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 800V 2A 3TO252
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3.9V @ 120µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO252-3
Serie	CoolMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2.7 Ohm @ 1.2A, 10V
Verlustleistung (max)	42W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	290pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	16nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	800V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	2A (Tc)

SPD02N80C3ATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SPD02N80C3ATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SPD02N80C3ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ SPD02N80C3ATMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SPD02N60C3BTMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 650V 1.8A DPAK</p>	 <p><b>SPD03N50C3</b> Infineon Technologies SPD03N50C3 Infineon Technologies</p>	 <p><b>SPD02N60S5BTMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 600V 1.8A TO-252</p>	 <p><b>SPD02N60C3_05</b> VB SPD02N60C3_05 VB</p>
 <p><b>SPD02N80C3BTMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 800V 2A TO-252</p>	 <p><b>SPD03N50C3BTMA1</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 560V 3.2A DPAK</p>	 <p><b>SPD02N60S5</b> infineo SPD02N60S5 infineo</p>	 <p><b>SPD03N60C3</b> Infineon Technologies SPD03N60C3 Infineon Technologies</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SPD02N80C3ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	SPD02N80C3ATMA1 Datenblatt	SPD02N80C3ATMA1-Datenblätter	SPD02N80C3ATMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) SPD02N80C3ATMA1
SPD02N80C3ATMA1 Electronic	SPD02N80C3ATMA1-Komponenten	SPD02N80C3ATMA1-Verteiler	SPD02N80C3ATMA1-Bild	SPD02N80C3ATMA1-Teil
SPD02N80C3ATMA1 Preis	SPD02N80C3ATMA1 Hersteller	SPD02N80C3ATMA1 Bild	SPD02N80C3ATMA1 Aktie	SPD02N80C3ATMA1 Inventar
SPD02N80C3ATMA1 Neu	SPD02N80C3ATMA1 Original	SPD02N80C3ATMA1 garantiert	SPD02N80C3ATMA1 RFQ	SPD02N80C3ATMA1 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited